



产品规格书

SPECIFICATIONS

深紫外核心材料 · AlGaIn模板

WAGN-AN001

1~2 μm , (002) \leq 300 arcsec, (102) \leq 300 arcsec



湖北深紫科技有限公司

Hubei DUVTEK Co., LTD.

湖北省鄂州市梧桐湖新区凤凰大道9号东湖高新科技创意城B08栋

Building B08, Donghu High-tech Innovation City, No. 9 Fenghuang Avenue, Wutong Lake New District, Ezhou, Hubei, China

1. 规格参数 Characteristics

性能 Properties	参数值 Value
直径 Diameter	50.8±0.05 μm
衬底类型 Substrate	AlN template
衬底厚度 Substrate Thickness	430±20 μm
外延层厚度 Epilayer Thickness	1~2 μm
(002) 晶体质量 Crystal quality (FWHM of 002 XRC)	≤ 300 arcsec
(102) 晶体质量 Crystal quality (FWHM of 102 XRC)	≤ 500 arcsec
正面粗糙度 Front side roughness	≤ 2 nm
边缘扣除 Edge exclusion	≤ 3 mm
贯穿裂纹 Through Crack	none
a面(11-20)取向 Surface orientation of a-plane	0°±0.1°
m面(11-20)取向 Surface orientation of m-plane	0.2°±0.1°
定位边晶向 Primary flat orientation	a-plane±0.1°
定位边长度 Primary flat length	16±1 mm
反面粗糙度 Back side roughness	0.8±0.2 μm

深紫科技，芯片级深紫外LED紫外杀菌技术开拓者

产品与解决方案

产品目录
深紫外核心材料
深紫外LED灯珠
深紫外LED模组
行业解决方案

支持与服务

联系我们
专家服务
技术分享
自助工具
反馈与建议

合作伙伴与生态

分销伙伴
解决方案伙伴

联系我们

销售/技术/合作: 15623097174 (陈经理)
联系邮箱: sales@duvtek.com (销售)
公司地址: 湖北省鄂州市梧桐湖新区凤凰大道9号东湖高新科技创意城B08栋



官方微信